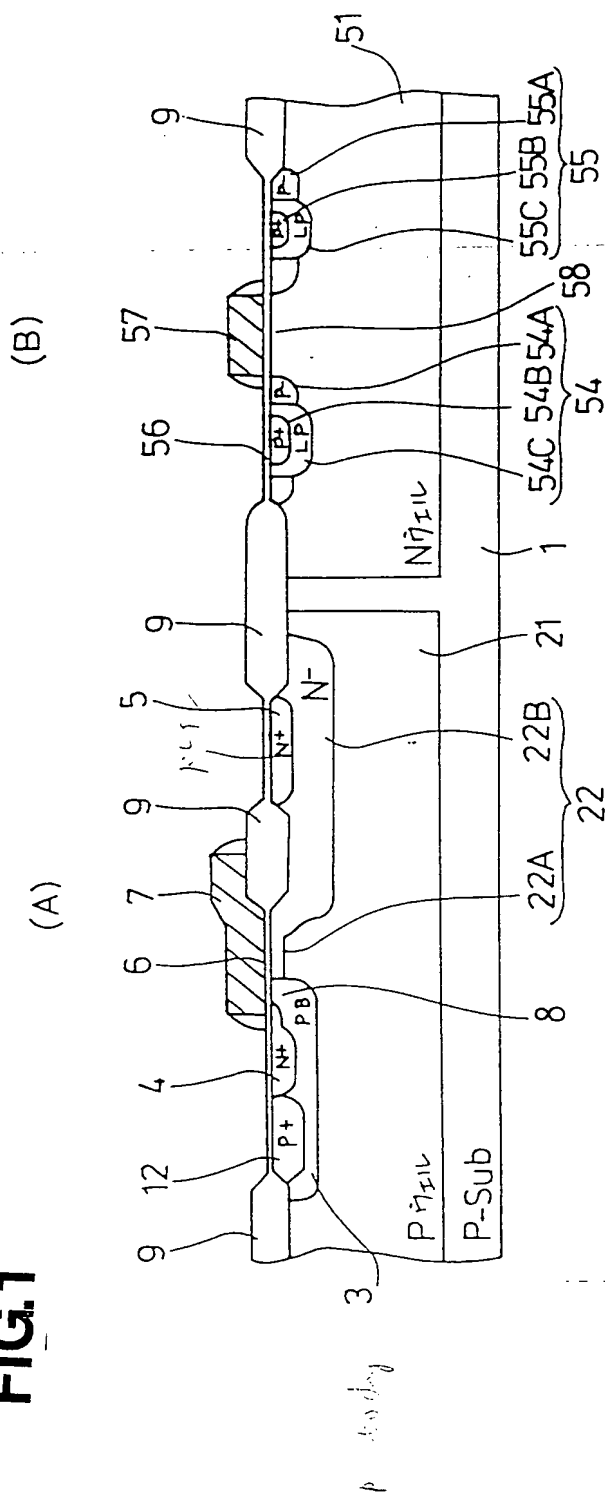


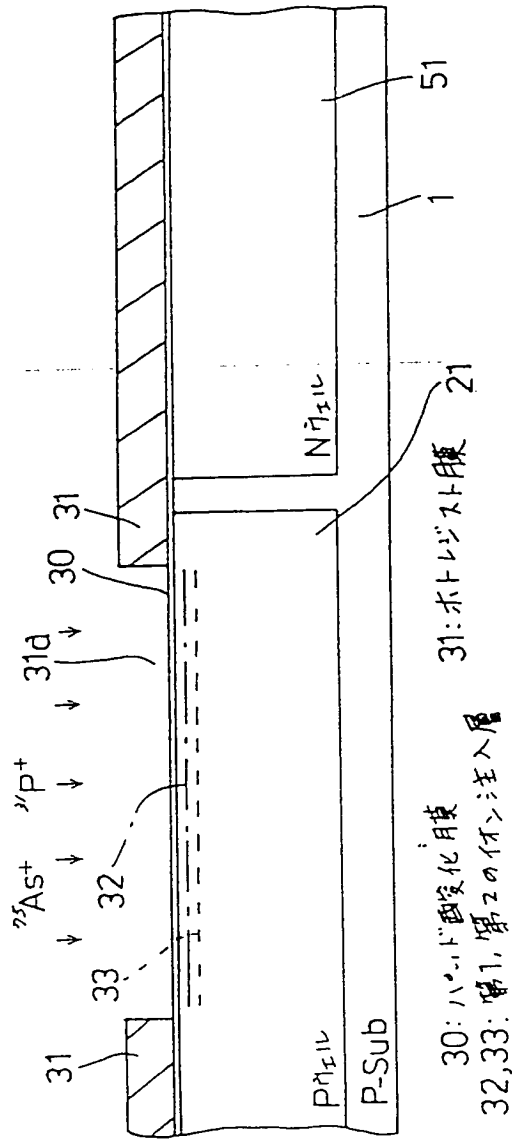
**FIG. 1**



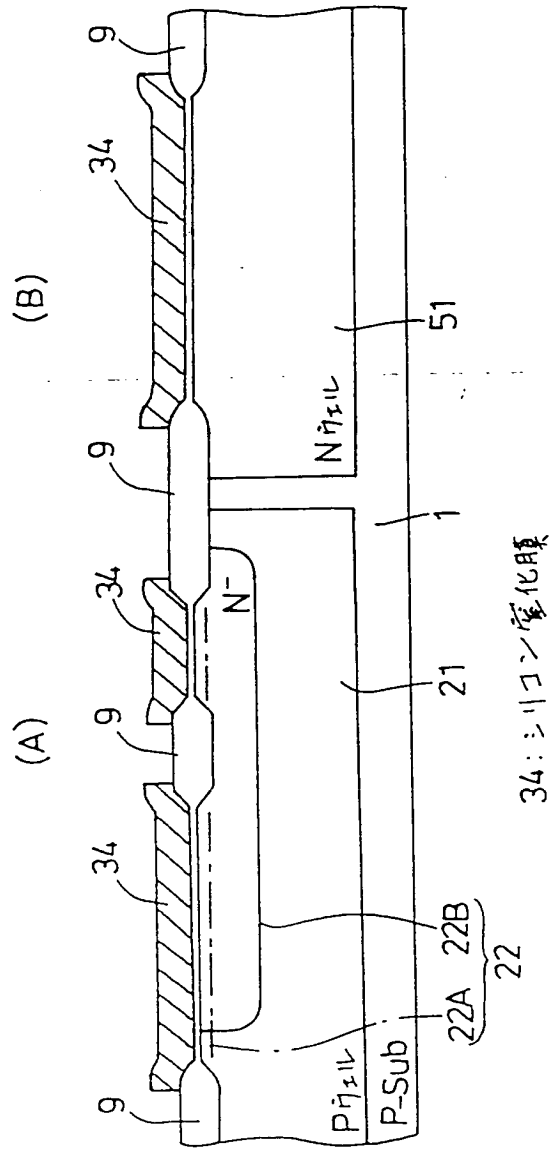
51: N型セル領域  
54,55: P型拡散領域  
56: H<sup>+</sup>-トゲル素膜  
57: H<sup>+</sup>-トゲル極  
58: ナネセル領域

21: P型ウエル領域  
22A: 第1のN-層  
22B: 第2のN-層  
22: N-層 (ドリフト領域)

**FIG. 2A**



**FIG. 2B**



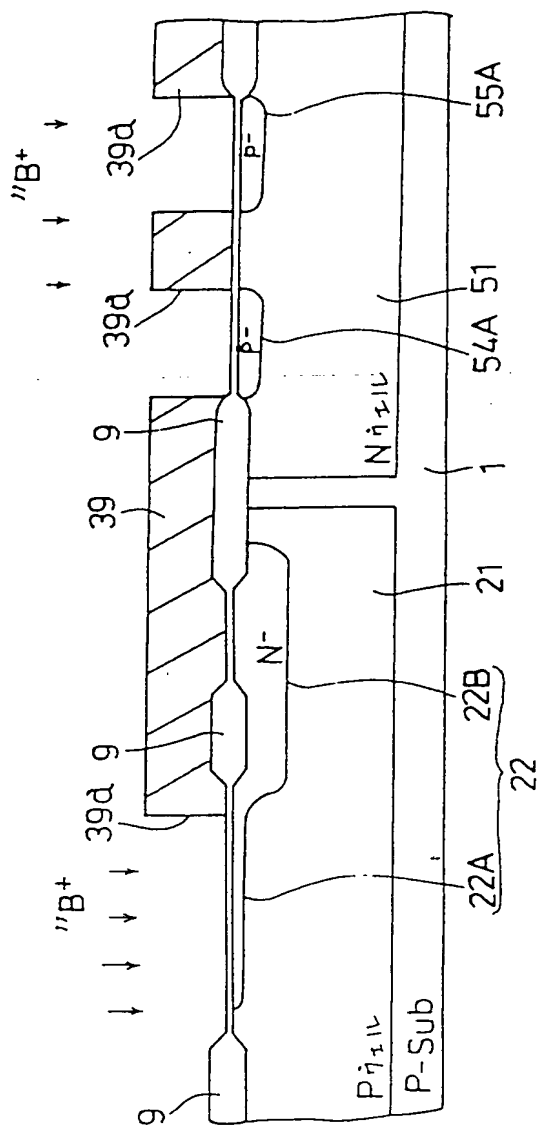


FIG. 3A

39:ホトリレジスト膜

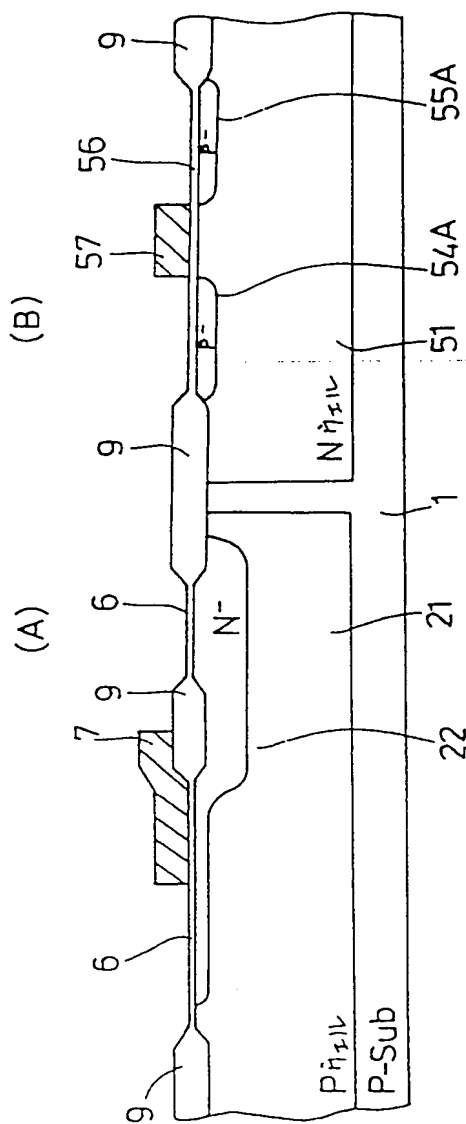
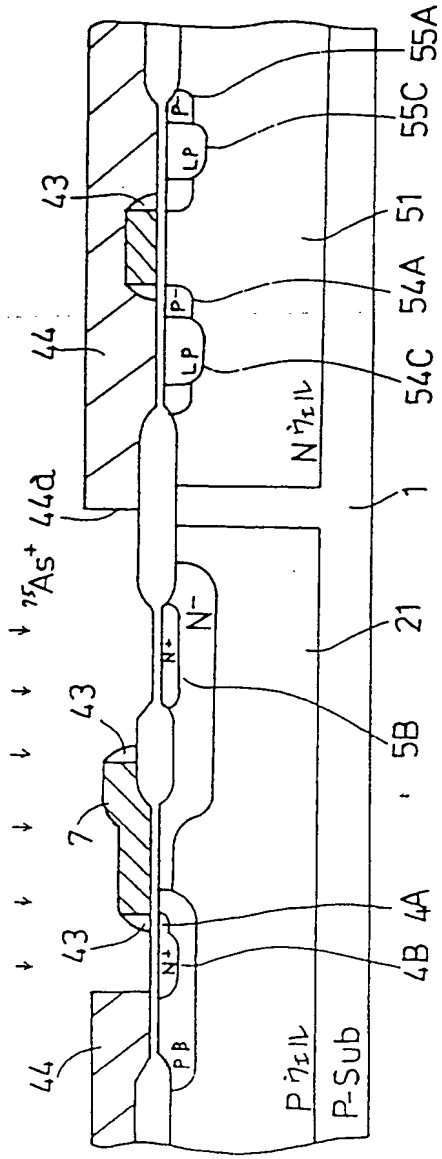


FIG. 3B



FIG.5A



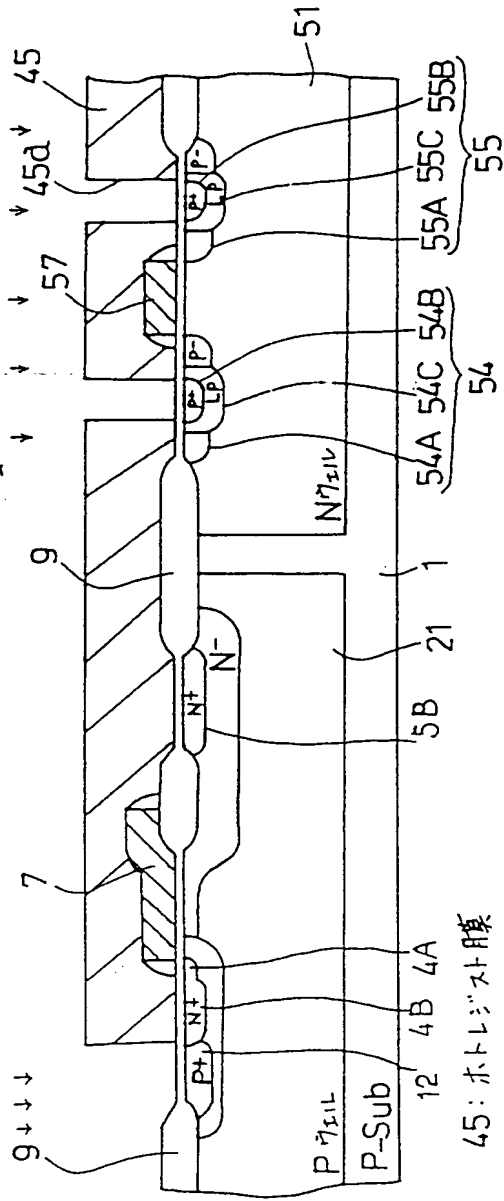
43:サイドウォールスパースーザ膜

44:ホトリジスト膜

(A)

$BF_3$

FIG.5B



45:ホトリジスト膜

提出日 平成10年12月10日

concentration 濃度

$^{75}\text{As}^+$

$^{11}\text{B}^+$

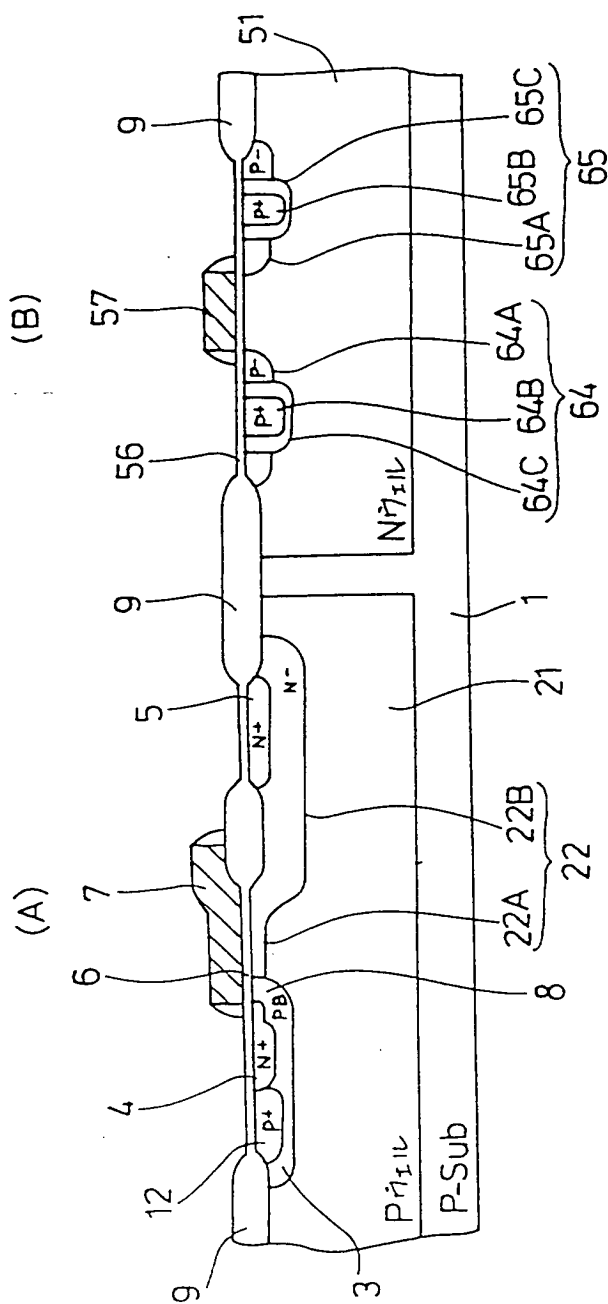
$^{31}\text{P}^+$

depth 基板深さ

**FIG. 6**

[illegible]

# FIG. 7

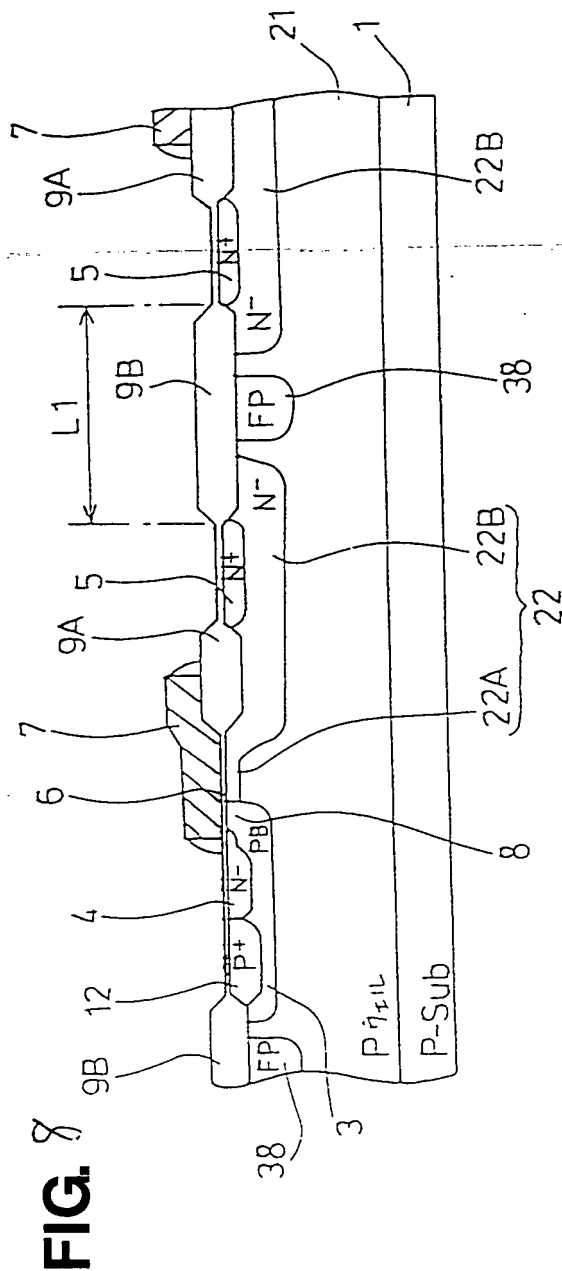


64,65: ノース・ドリンフィールド

【書類名】 図面

【図 1】

8

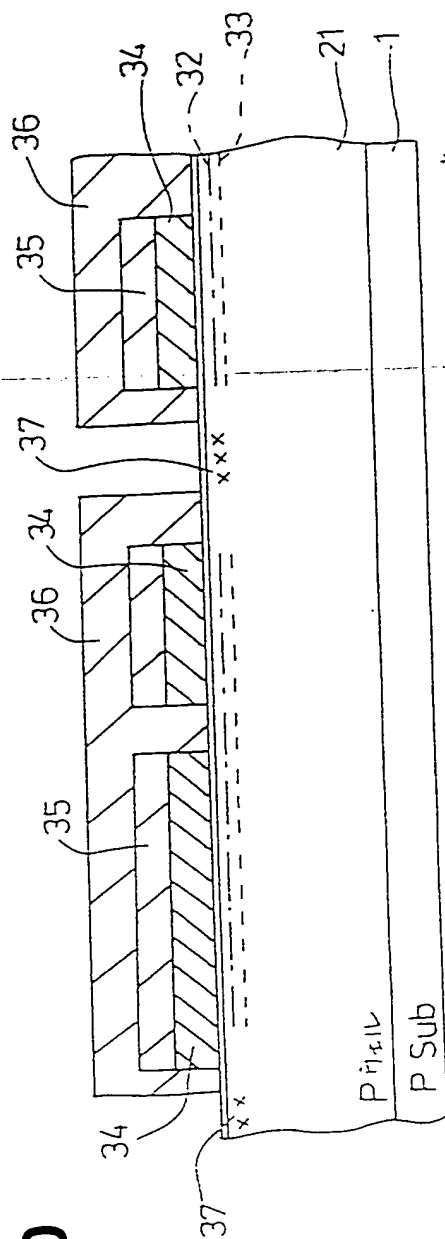


21: P型ウェル令具±或  
22A: 第1のN<sup>-</sup>層  
22: N<sup>-</sup>層(ドリフト令具±或)  
22B: 第2のN<sup>-</sup>層  
38: チャネルスト、パ<sup>ラ</sup>層





FIG.10



34: シリコン窒化膜  
35, 36: 第1, 第2のホトレジスト膜  
37: 4-メチルベンゾエチン樹脂注入層

10/22

提出日 平成10年12月 4日

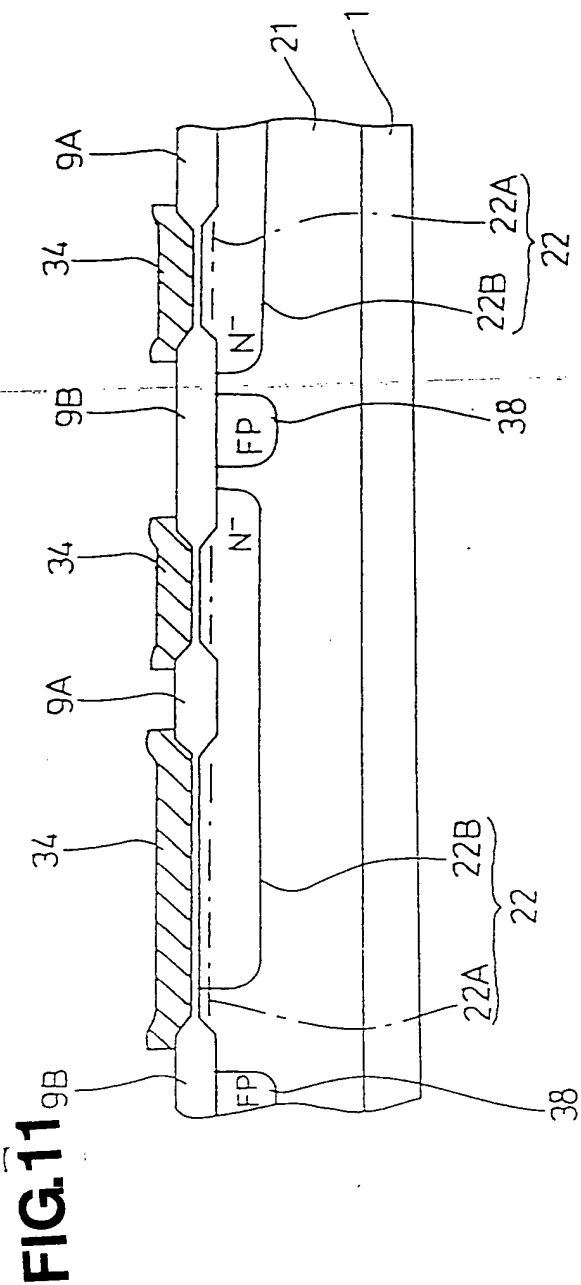
発明名称=KIA0980186

11/22

提出日 平成10年12月 4日

発明番号=K I A 0 9 8 0 1 8 6

//

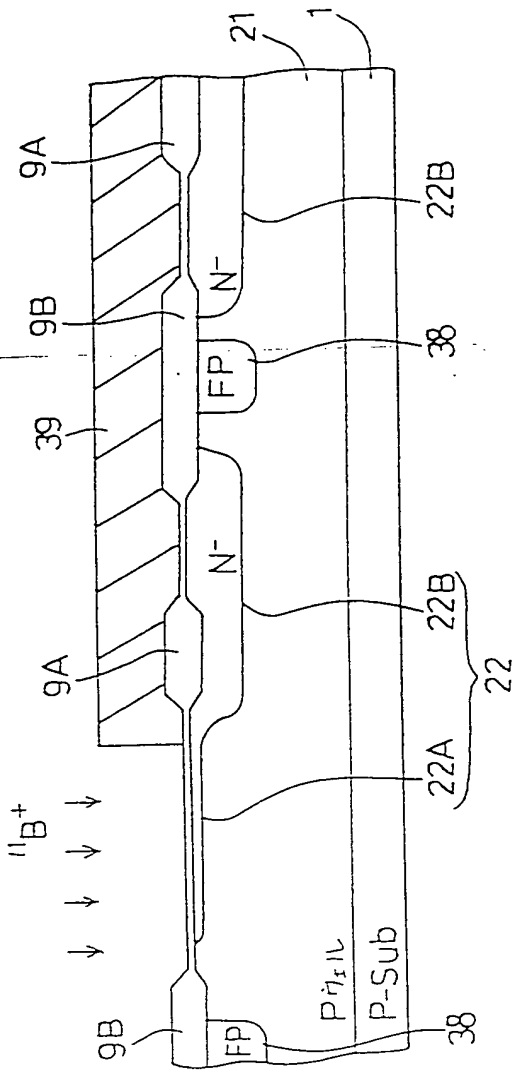


//

12/22

提出日 平成10年12月 4日

整理番号=K I A 0 9 8 0 1 8 6



39: ポリシリコン膜

FIG.12

Doc. 01800000

60227-674460

特許出願番号=K1A0980186

13/22

提出日 平成10年12月 4日

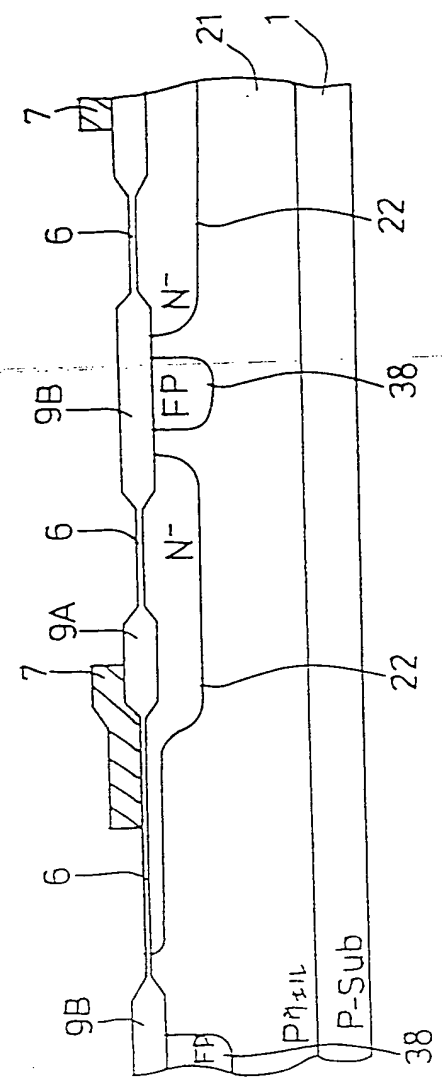
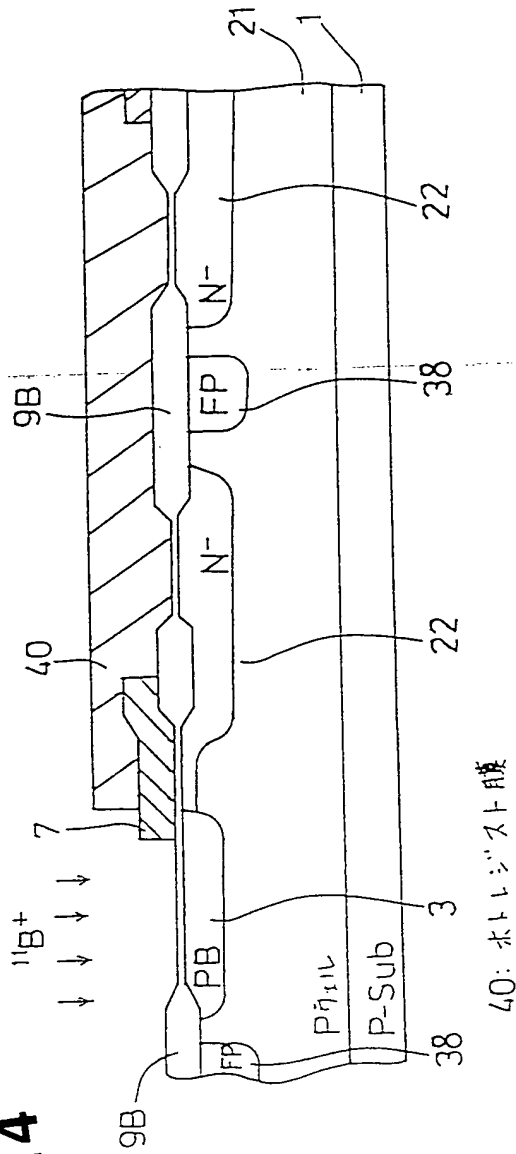


FIG.13

Figure 1 shows the results of the analysis of variance for the effect of the different factors on the response variables. The analysis of variance for the effect of the different factors on the response variables is presented in Table 1. The analysis of variance for the effect of the different factors on the response variables is presented in Table 1. The analysis of variance for the effect of the different factors on the response variables is presented in Table 1.

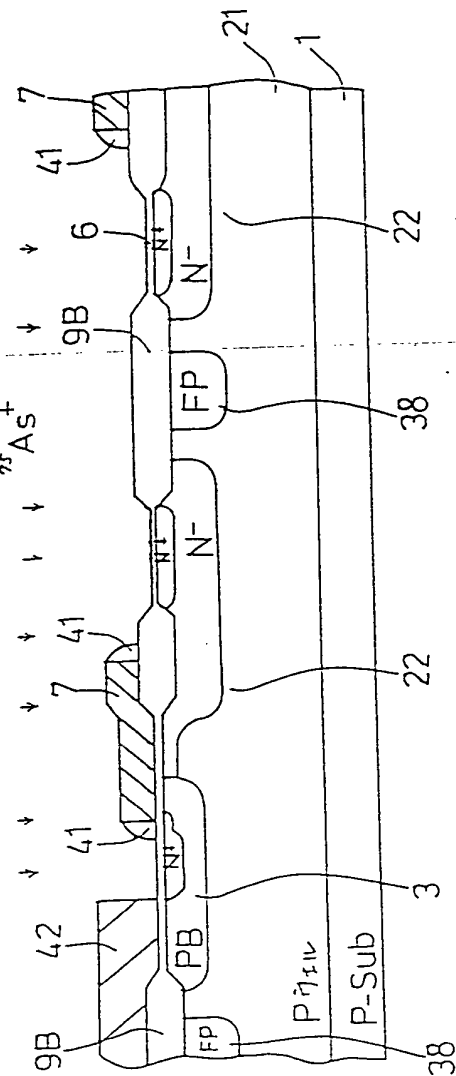
**FIG. 14**



15/22

提出日 平成10年12月 4日

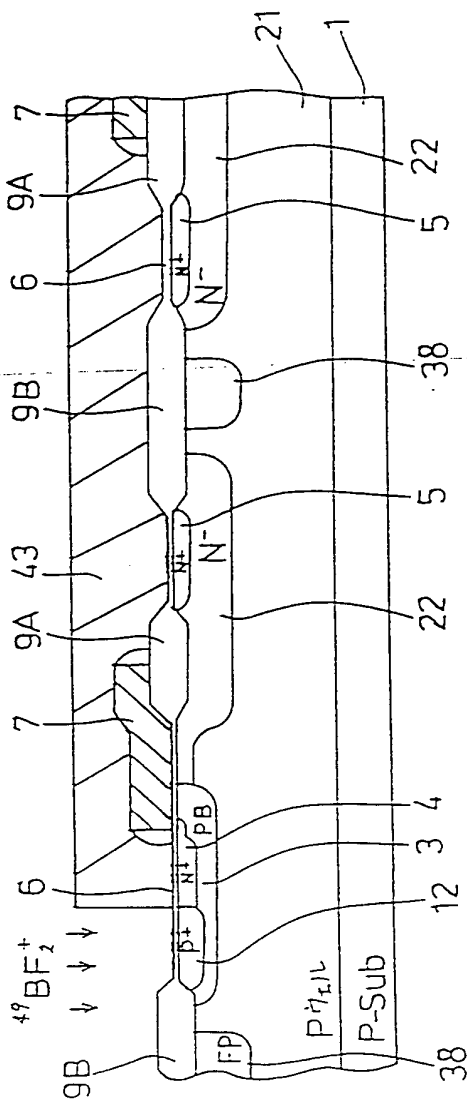
整理番号=KIA0980186



41: ゲイトエレクトロード膜 42: ポリシリコン膜

FIG.15

16



**FIG. 16**

43: ホトトギス ト 目 録



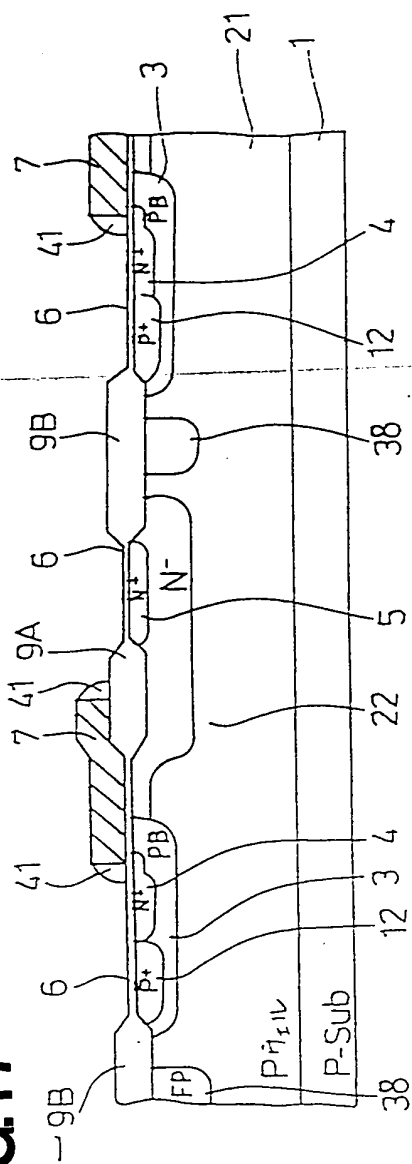
提出日 平成10年12月 4日

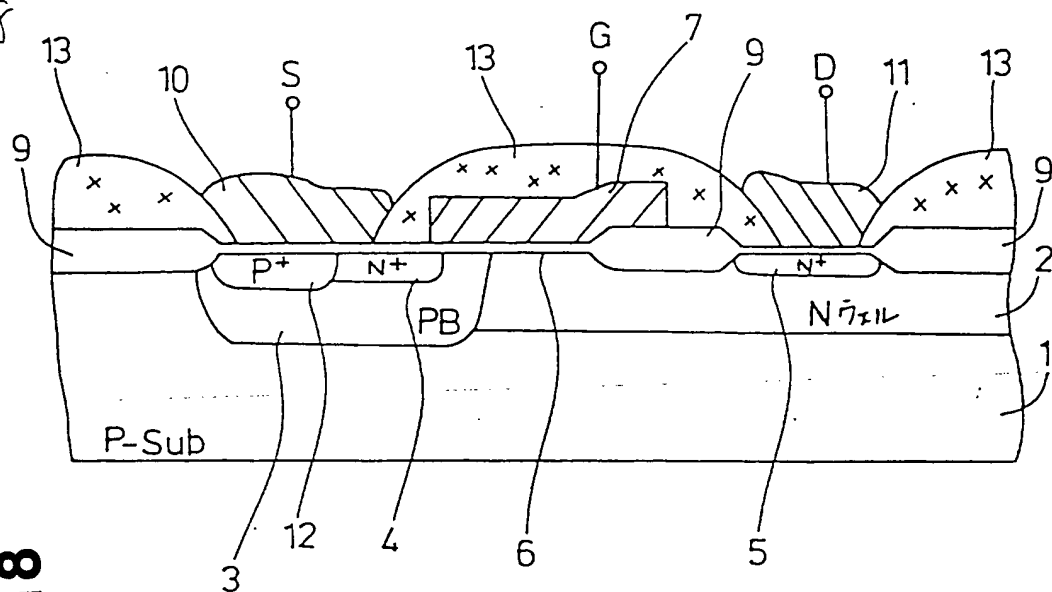
整理番号=K I A 0 9 8 0 1 8 6

17

[illegible]

**FIG. 17**





19/22

提出日 平成10年12月10日

整理番号=K I A 0 9 8 0 1 9 6

FIG.19A

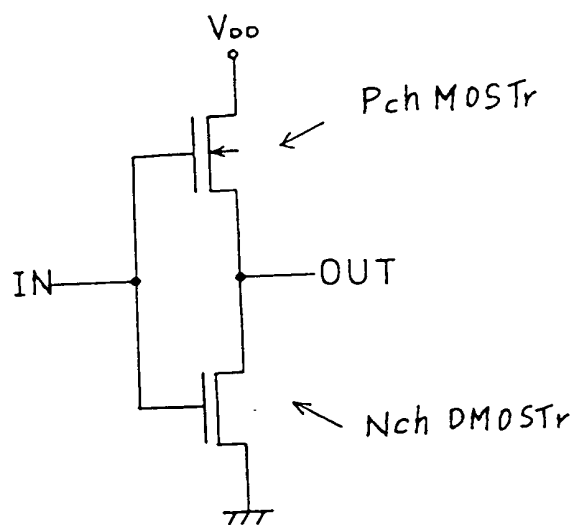
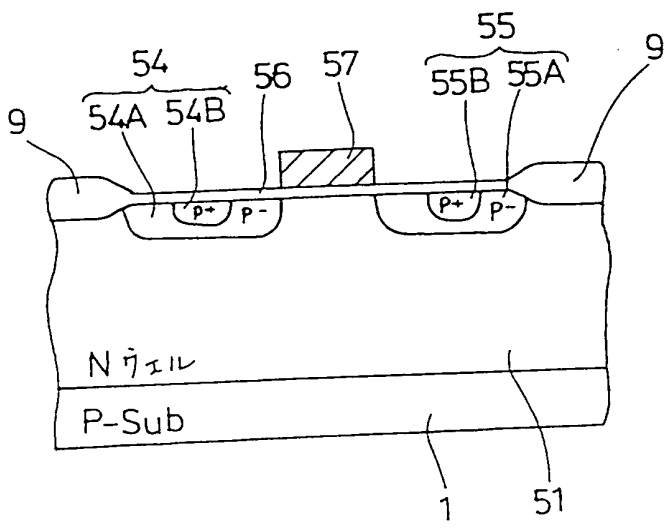
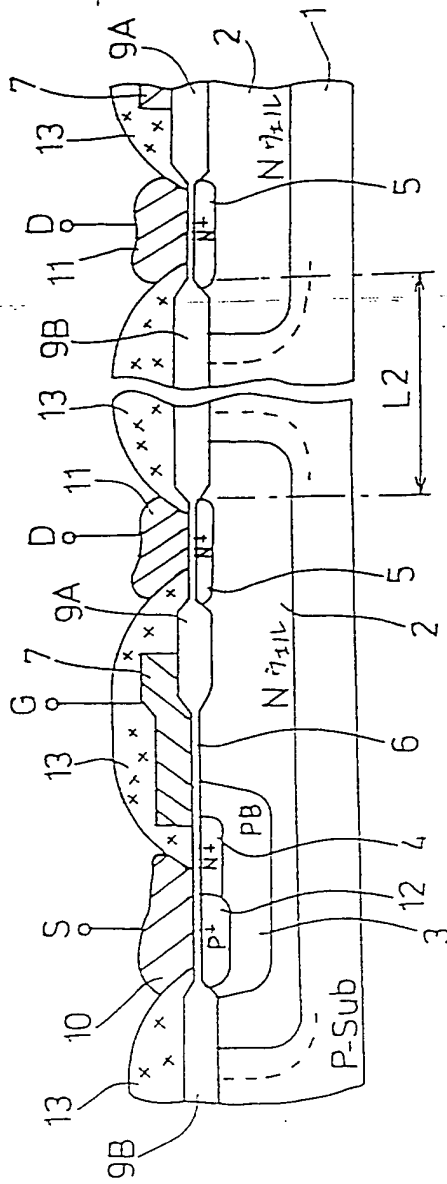


FIG.19B



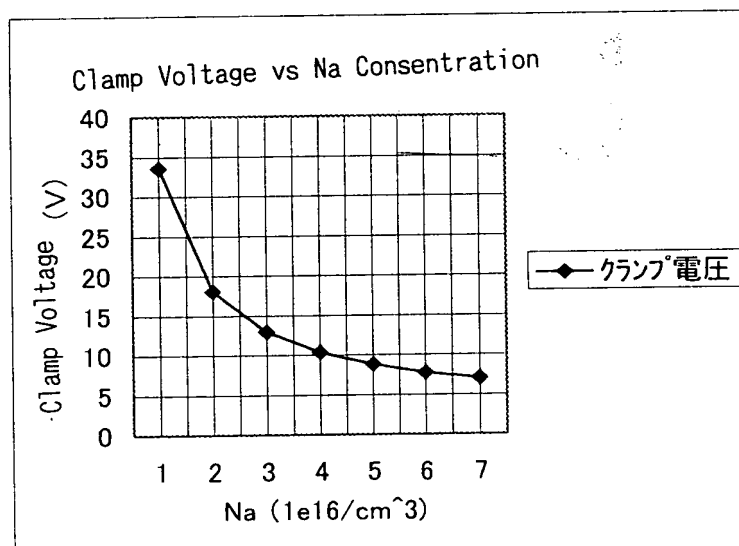
【図 1-2】.



**FIG. 20**

21/22

SECRET: OFFICIAL



**FIG.21**

N-Clamp Voltage vs Na Concentration  
 Stepped Junction N-Concentration  $1 \times 10^{17} / \text{cm}^3$   
 $X_j = 0.2 \mu\text{m}$

22/22

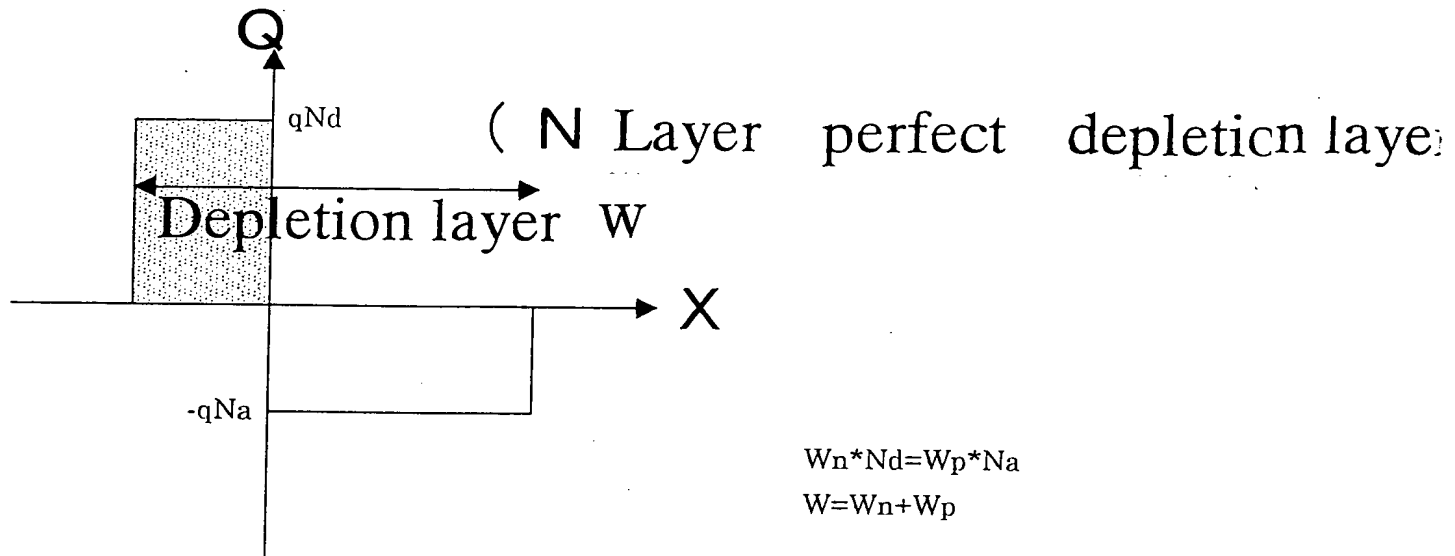
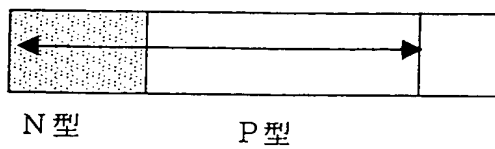


Fig.22 Stepped Junction